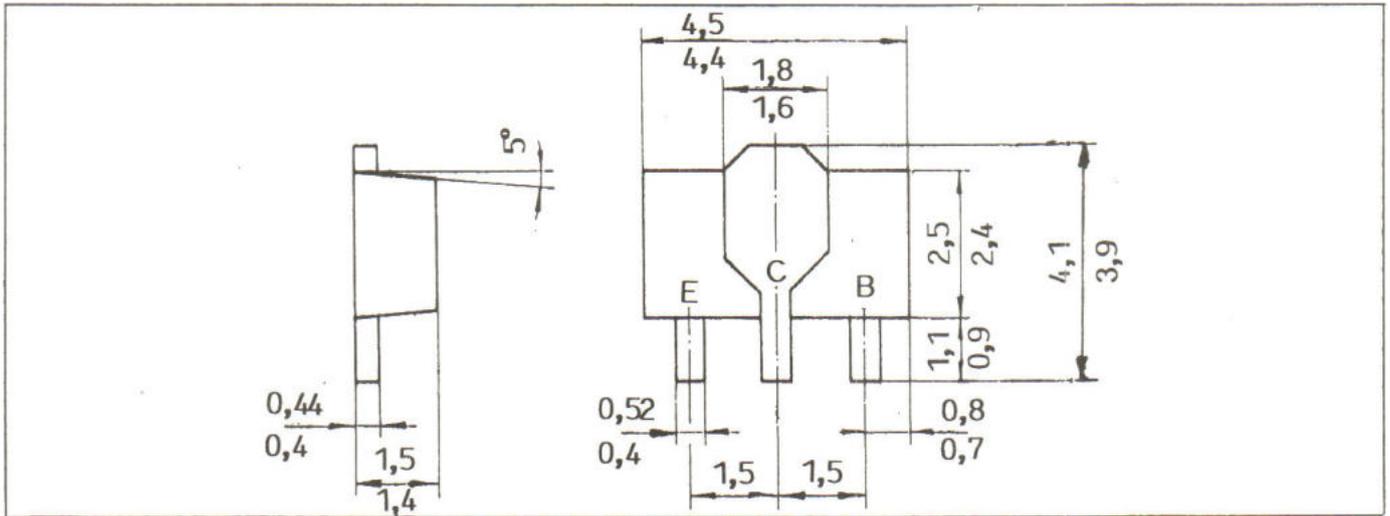


# SSE 560/561/562 Si-PNP-Transistor

Silizium-PNP-Planar-Darlington-Transistoren für Anwendungen in der Hybrid- und Auf-  
setztechnik



Maßbild mit Anschlußbelegung

Gehäuse: SOT-89

## Grenzwerte

Grenzwert	Kurz- zeichen	min.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$		60 <sup>1)</sup>	V
			80 <sup>2)</sup>	V
			90 <sup>3)</sup>	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$		45 <sup>1)</sup>	V
			60 <sup>2)</sup>	V
			80 <sup>3)</sup>	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$		5	V
Kollektorstrom	$-I_C$		0,5	A
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$		1,5	A
Basisstrom	$-I_B$		100	mA
Gesamtverlustleistung bei $T_{amb} \leq 25 \text{ °C}$ - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm <sup>2</sup> Fläche	$P_{tot}$		1	W
Sperrschichttemperatur	$T_j$		150	°C
Betriebstemperaturbereich	$T_{stg}$	-55	125	°C

1) SSE 560; 2) SSE 561; 3) SSE 562

## Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Wärmewiderstände zwischen Sperrschicht und Umgebung - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm <sup>2</sup> Fläche	$R_{thja}$		125	K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektor	$R_{thjc}$		10	K/W

## Ausgewählte Kennwerte ( $T_{amb} = 25\text{ °C}$ )

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Kollektor-Emitter- Reststrom	$-I_{CES}$	$U_{BE} = 0$ $-U_{CE} = -U_{CERmax}$			10	$\mu A$
Emitter-Reststrom	$-I_{EBO}$	$I_C = 0$ $-U_{EB} = 4\text{ V}$			10	$\mu A$
Kollektor-Emitter- Restspannung	$-U_{CEsat}$	$-I_C = 0,5\text{ A}$ $-I_B = 0,5\text{ mA}$			1,3	V
Basisspannung	$-U_{BEsat}$	$-I_C = 0,5\text{ A}$ $-I_B = 0,5\text{ mA}$			1,9	V
Gleichstromverstärkung	$h_{FE}$	$-I_C = 0,15\text{ A}$	1000			
	$h_{FE}$	$-I_C = 0,5\text{ A}$	2000			
Schaltzeiten	$t_{ein}$	$-I_{CX} = 0,5\text{ A}$ $-I_{BX} = 0,5\text{ mA}$		0,4		$\mu s$
	$t_{aus}$	$-I_{CX} = 0,5\text{ A}$ $-I_{BX} = 0,5\text{ mA}$		1,5		$\mu s$